

Сведения об официальном оппоненте

ФИО	Рыжук Роман Валериевич
Ученая степень	кандидат технических наук
Наименование отрасли науки, специальностей, по которым защищена диссертация	05.27.01 – «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах»
Полное наименование организации	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Должность	Старший научный сотрудник
Список основных публикаций в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	<ol style="list-style-type: none"> 1. Electrical Characteristics and Deep Traps Spectra of Undoped GaN Films Grown on Si Using Different Strain-Relieving Buffer Types / A.Y. Polyakov, N.B. Smirnov, Cheong Hyun Roh et. al. IEEE Transactions on Nanotechnology, Vol. 13, NO.1, 2014. PP 151 – 159 2. Ионная компенсация диодных структур карбида кремния / В.А. Гудков, Р.В. Рыжук, Н.И. Каргин и др. Вестник Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». 2013. Том 2. №4. С. 404-408 3. Effects of annealing in oxygen on electrical properties of AlGaIn/GaN heterostructures grown on Si / A.Y. Polyakov, N.B. Smirnov, Min-Woo Ha et. al. Journal of Alloys and Compounds, Vol. 575. 2013г. С. 17–23 4. Effect of electron irradiation on AlGaIn/GaN and InAlN/GaN heterojunctions / Ya-Shi Hwang, Lu Liu, and Fan Ren et. al. J. Vac. Science &Technology B 31(2), 2013, PP 022206-1/022206-6 5. Deep Centers and Persistent Photocapacitance in AlGaIn/GaN High Electron Mobility Transistor Structures Grown on Si Substrates / Alexander Y. Polyakov, N. B. Smirnov, A. V. Govorkov et. al. J. Vac. Science &Technology B 31(1), Volume 31, Issue 1, 2012. PP 011211-1/ 011211-5 6. Влияние энергии и дозы имплантации на напряжение пробоя карбидокремниевых p-n-

	<p>структур / Р.В. Рыжук, Г.К. Сафаралиев, Б.А. Билалов и др. Вестник Дагестанского государственного университета. 2012, Выпуск 6. Естественные науки. С.30-34</p> <p>7. Исследование влияния технологических режимов на величину удельного переходного сопротивления контактов к карбиду кремния / Р.В. Рыжук, Н.И. Каргин, М.Н. Стриханов и др. // Ядерная физика и инжиниринг, 2012, том 3, № 4, с. 380–384</p> <p>8. Разработка энергоэффективного светильника на основе наногетероструктур InGaN/GaN/AlGaN / Н.И. Каргин, Р.В. Рыжук, А.М. Коновалов и др. // Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы, Выпуск 1 (228), 2012, С. 90-94</p>
Почтовый адрес	115409, г. Москва, Каширское ш., 31
Телефон	8(495)788-56-99, доб. 8439
Адрес электронной почты	ryzhuk-rom@yandex.ru

Официальный оппонент

Кандидат технических наук,
старший научный сотрудник
Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ»



Рыжук Роман Валериевич

Подпись Рыжука Романа Валериевича удостоверяю
Шашина Татьяна Сергеевна,
заместитель начальника отдела
документационного обеспечения

дата

